





|   |   |
|---|---|
|  | <h2>SI1414DH-T1-GE3</h2>  |
|   | <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI1414DH-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 4A SOT-363</p> <p><b>Datenblätter:</b>  SI1414DH-T1-GE3.pdf</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 15391 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p>            |   |

### Spezifikationen

|  |   |
|--|---|
| Teilenummer                                      | SI1414DH-T1-GE3                                     |
| Hersteller                                       | Electro-Films (EFI) / Vishay                        |
| Beschreibung                                     | MOSFET N-CH 30V 4A SOT-363                          |
| Kategorie  | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,    |
| Teilstatus                                       | 15391 pcs Stock                                     |
| detaillierte Beschreibung                        | N-Channel 30V 4A (Tc) 1.56W (Ta), 2.8W (Tc) Surface |
| Serie  | TrenchFET®  |
| Technologie                                      | MOSFET (Metal Oxide)                                |
| Betriebstemperatur                               | -55°C ~ 150°C (TJ)                                  |
| Befestigungsart                                  | Surface Mount                                       |
| Verpackung / Gehäuse                             | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363                             |
| Supplier Device-Gehäuse                          | SOT-363   |
| Verlustleistung (max)                            | 1.56W (Ta), 2.8W (Tc)                               |
| Typ FET  | N-Channel   |
| FET-Merkmal                                      | -   |
| Drain-Source-Spannung (Vdss)                     | 30V   |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 4A (Tc)   |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs                           | 46 mOhm @ 4A, 4.5V                                  |
| VGS (th) (Max) @ Id                              | 1V @ 250µA  |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs                     | 15nC @ 8V   |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds              | 560pF @ 15V   |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)        | 1.8V, 4.5V  |
| Vgs (Max)  | ±8V   |
| Verpackung                                       | Tape & Reel (TR)                                    |
| Bleifreier Status / RoHS-Status                  | Lead free / RoHS Compliant                          |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)        | 1 (Unlimited)                                       |
| Andere Namen                                     | SI1414DH-T1-GE3-ND                                  |

SI1414DH-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI1414DH-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1414DH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1414DH-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  <p><b>SI1413EDH-T1-E3</b><br/>Vishay / Siliconix<br/>MOSFET P-CH 20V 2.3A SC70-6</p>   |  <p><b>SI1416EDH-T1-GE3</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>MOSFET N-CH 30V 3.9A SOT-363</p> |  <p><b>SI1413EDH-T1</b><br/>VISHAY<br/>SI1413EDH-T1 VISHAY</p>                          |  <p><b>SI1417DH-T1-E3</b><br/>VISHAY<br/>SI1417DH-T1-E3 VISHAY</p>                   |
|  <p><b>SI1413EDH-T1-GE3</b><br/>Vishay / Siliconix<br/>MOSFET P-CH 20V 2.3A SC-70-6</p> |  <p><b>SI1413EDH-T1-GE3</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>MOSFET P-CH 20V 2.3A SC-70-6</p> |  <p><b>SI1416EDH-T1-GE3</b><br/>Vishay / Siliconix<br/>MOSFET N-CH 30V 3.9A SOT-363</p> |  <p><b>SI1414DH-T1-GE3</b><br/>Vishay / Siliconix<br/>MOSFET N-CH 30V 4A SOT-363</p> |

### heiße Teile

Mehr

|                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SI1405DL-T1      | SI1405DL-T1-E3   | SI1405DL-T1-E3   | SI1406DH         | SI1406DH-T1      |
| SI1406DH-T1-E3   | SI1406DH-T1-E3   | SI1406DH-T1-GE3  | SI1406DH-T1-GE3  | SI1407DL         |
| SI1407DL-T1      | SI1407DL-T1-E3   | SI1407DL-T1-GE3  | SI1410EDH        | SI1410EDH-T1     |
| SI1410EDH-T1-E3  | SI1410EDH-T1-E3  | SI1410EDH-T1-GE3 | SI1413DH-T1      | SI1413EDH        |
| SI1413EDH-T1     | SI1413EDH-T1-E3  | SI1413EDH-T1-GE3 | SI1413EDH-T1-GE3 | SI1413EDH-T1-GE3 |
| SI1414DH-T1-GE3  | SI1416EDH-T1-GE3 | SI1416EDH-T1-GE3 | SI1417DH-T1-E3   | SI1417DH-T1-GE3  |
| SI1417EDH-T1     | SI1417EDH-T1-E3  | SI1417EDH-T1-E3  | SI1417EDH-T1-GE3 | SI1417EDH-T1-GE3 |
| SI1422DH-T1-GE3  | SI1422DH-T1-GE3  | SI1424EDH-T1-GE3 | SI1424EDH-T1-GE3 | SI1426DH-T1-E3   |
| SI1426DH-T1-E3   | SI1426DH-T1-GE3  | SI1426DH-T1-GE3  | SI1427EDH-T1-GE3 | SI1427EDH-T1-GE3 |
| SI1428EDH-T1-GE3 | SI1428EDH-T1-GE3 | SI1433DH-T1      | SI1433DH-T1-E3   | SI1433DH-T1-E3   |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited